



# 深度\*行业\*半导体新股系列 4- 拓荆科技：主导 PECVD、 SACVD、ALD 等薄膜沉积设备 国产化



概况: 7月12日, 拓荆科技股份有限公司披露招股说明书(申报稿), 本次募集资金10亿元用于高端半导体设备扩产项目、先进半导体设备的技术研发与改进项目、ALD设备研发与产业化项目以及补充流动资金。

## 公司亮点

聚焦于薄膜沉积设备, 营业收入高速增长。公司主要从事半导体薄膜沉积设备国产化, 主要产品包括等离子体增强化学气相沉积(PECVD)设备、原子层沉积(ALD)设备和次常压化学气相沉积(SACVD)设备三个产品系列。

2018-2020年公司营业收入依次是0.71亿元、2.51亿元、4.36亿元; 净利润依次为-1.03亿元、-0.19亿元、-0.11亿元; 毛利率分别是33.00%、31.99%、34.12%, 收入显著增长, 毛利率稳定, 亏损逐年收窄。公司2018-2020年研发费用占营业收入的比例分别为152.84%、29.58%、28.19%。

拓荆科技是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商, 产品关键性能和技术已达到国际先进水平。主要产品已广泛应用于国内晶圆厂14nm及以上制程集成电路制造产线, 并已展开10nm及以下制程产品验证测试。公司产品已广泛用于中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储、厦门联芯、燕东微电子等国内主流晶圆厂产线, 累计发货超150套机台。公司生产的PECVD设备已发货某国际领先晶圆厂先进制程研发产线; SACVD设备可以沉积BPSG、SAF材料薄膜, 适配12英寸

40/28nm 以及 8 英寸 90nm 以上的逻辑芯片制造工艺需求；同时，公司自主研发的核心技术解决了半导体制造中纳米级厚度薄膜均匀一致性、薄膜表面颗粒数量少、快速成膜、设备产能稳定高速等关键难题，保证实现薄膜工艺性能，且能减少客户产线的生产成本。公司的产品已适配国内最先进的 28/14nm 逻辑芯片、19/17nm DRAM 芯片和 64/128 层 3DNANDFLASH 晶圆制造产线，2.5D、3D 先进封装及其他泛半导体领域。

薄膜沉积设备市场规模增长较快，拓荆科技有望引领国产化进程。薄膜沉积设备负责各工序中的介质层与金属层的沉积，包括 CVD（化学气相沉积）设备、PVD（物理气相沉积）设备/电镀设备和 ALD（原子层沉积）设备。其中 ALD 属于 CVD 的一种，是先进制程部分工序节点所需的薄膜沉积设备。薄膜沉积设备的投资规模占晶圆制造设备总投资的 20%左右，年度市场规模约为 120-160 亿美元。受益于全球半导体高景气和制程进步带来工序增加，薄膜沉积设备需求迎来持续提升，且拓荆科技有望在国际巨头垄断局面中进一步提升市场份额。

募投项目：扩大产能水平，提高国产半导体专用设备市占率。本次募集资金 10 亿元用于高端半导体设备扩产项目、先进半导体设备的技术研发与改进项目、ALD 设备研发与产业化项目以及补充流动资金。致力于扩大公司现有生产基地的产能水平，为公司在上海临港新建研发生产场地。

建立贴近市场、提供具有快速响应客户需求的研发生产能力。实现产品的产业化，进一步提升产品技术水平和拓展产品应用领域，推动公司业

务规模的持续增长。

### 投资建议

作为国内稀缺的 12 英寸 PECVD、SACVD、ALD 设备企业，拓荆近年来的高成长性代表着国内工艺设备龙头的再次步入成熟，且国内市场需求旺盛。继续强烈推荐半导体设备板块，推荐组合：中微公司、北方华创、万业企业、精测电子、芯源微、长川科技、华峰测控，关注 ACMResearch、晶盛机电等。

### 评级面临的主要风险

地缘政治摩擦的不确定；零部件供应链安全的不确定性。

关键词：芯片

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_32752](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_32752)

